

摘要：采用补偿法对六甲基二硅胺烷 (hexamethydisilane ,HMDS)和二氯二甲基硅烷 (dichlorodimethylsilane ,DCDMS)化学表面修正恒压电晕充电硅基氮化硅 ( $\text{Si}_3\text{N}_4$ )薄膜驻极体及氮化硅 /二氧化硅 ( $\text{Si}_3\text{N}_4/\text{SiO}_2$ )薄膜驻极体的电荷储存稳定性进行了比较性的研究 .实验结果表明 ,经过化学表面修正后 ,驻极体薄膜在高湿环境中的电荷储存稳定性显著提高 ;在低于  $200^\circ\text{C}$ 时 ,HMDS 和 DCDMS 化学表面修正的效果相当 ;DCDMS 化学表面处理具有较高的耐热性 .